

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

into contact with a conductive upper member on the upper part of the chamber; a plurality of arc-shaped conductive members disposed in arc-shaped grooves provided in the first and second conduction surfaces; and two or more lifting and lowering mechanisms for lifting and lowering the valve body. When the opening is closed, the first conduction surface comes into contact with the rear surface of the baffle plate in the vertical direction to be electrically conducted by means of the conductive members. When the opening is closed, the second conduction surface comes into contact with the upper member in the vertical direction to be electrically conducted by means of the conductive members.

(57) 要約: 基板処理装置は、開口部を有する円筒状のチャンバと、開口部を開閉するシャッタ機構と、基板支持部と、基板支持部とシャッタ機構との間に設けられるバッフル板とを有する。シャッタ機構は、チャンバの内周のうち半分以上の長さを有する弁体と、弁体の下部においてバッフル板の裏面と接触する第1の導通面と、弁体の上部においてチャンバ上部の導電性の上部部材と接触する第2の導通面と、第1、第2の導通面に設けられる円弧状の溝に配置される複数の円弧状の導電性部材と、弁体を昇降させる2つ以上の昇降機構とを備える。第1の導通面は、開口部を閉じた場合にバッフル板の裏面と上下方向に当接し導電性部材により電氣的に導通する。第2の導通面は、開口部を閉じた場合に上部部材と上下方向に当接し導電性部材により電氣的に導通する。